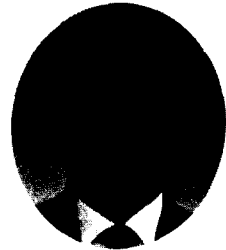


DRAM 특집을 내면서



진 대 제

(삼성전자 반도체 연구소 이사)

매 3년마다 차세대(次世代)가 개발되는 DRAM은 1985년에 1Mb DRAM, 1988년에 4Mb DRAM이 시판되기 시작했으며 이미 日本에서는 Toshiba, Hitachi등 5~6개 회사가 ISSCC에 16Mb DRAM 시제품을 발표했다. 우리나라도 1983년부터 삼성, 금성, 현대 등 3사(三社)에서 대규모 투자가 행해졌으며 정부와 ETRI 주도하에 4Mb DRAM개발을 공동으로 성공리에 완수하였다. 금년부터는 16M/64M 개발 계획이 수립되어 추진될 예정이다.

반도체 사업은 이미 그 자체로서의 중요성 뿐만 아니라 정보통신, 가전제품 및 정밀기기의 모든 system에 사용되어 부가가치를 높이는 기간산업으로 발전해가고 있음은 주지의 사실이다. 특히 DRAM은 고화질TV(HDTV)에도 사용되어 market의 급격한 성장이 예상된다.

금번 DRAM 특집은 이러한 국내외 상황에 적절한 timing과 내용을 게재하고 있다. 즉 한국반도체 산업의 현황과 최근 관심이 고조되고 있는 각사(各社)의 16Mb DRAM의 비교분석 및 DRAM의 설계와 공정상의 문제를 다루고 있으며, 아울러 'DRAM은 끝없이 세대가 발전될 수 있는가' 하는 의문에 대한 논의도 포함되어 있다.

아무쪼록 이 글이 회원 여러분에게 유익한 지식과 정보가 되기를 기원하며 바쁘신 가운데 좋은 원고를 내주신 필자들에게 심심한 감사를 드린다.

1989年 4月